	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W2XP011F	文件编号	XS-W-081
	高频放大环境额定双极型晶体管	版本号	18-B2-07
		页码	1/3

1 主要用途及主要特点

1.1 主要用途

用 W2XP011F 芯片封装的成品管主要用于低压电源调整电路及一般高频放大电路。

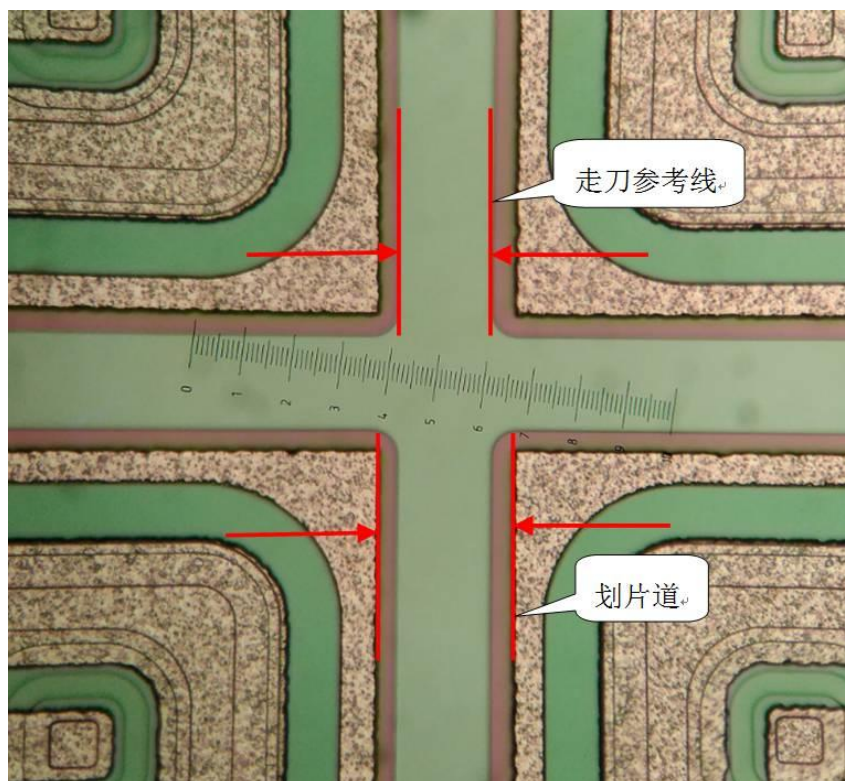
1.2 主要特点

- 击穿电压高
- 饱和电压较低

2 芯片数据

	芯片尺寸 (mm×mm)	1.1×1.1	
	芯片厚度 (μm) (推荐)	220±20	
	划片道尺寸 (μm)	50	
	键合区面积 (μm ²)	基区	240×350
		发射区	230×230
	钝化层		Si ₃ N ₄
	正面电极	金属	铝
		厚度 (μm)	4.0±0.6
	背面电极	金属	银
	硅片直径 (mm)	Φ125	
	装片要求(推荐)	锡铅烧结	
	键合要求(推荐)	铜丝: Φ42μm; E、B区各一根	

* 划片道位置示意图:



备注: 划片道两侧的铝条不断裂即判为合格。


江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: <http://www.xs-elec.com>

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W2XP011F	文件编号	XS-W-081
	高频放大环境额定双极型晶体管	版本号	18-B2-07
		页码	2/3

3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

3.1 极限值

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

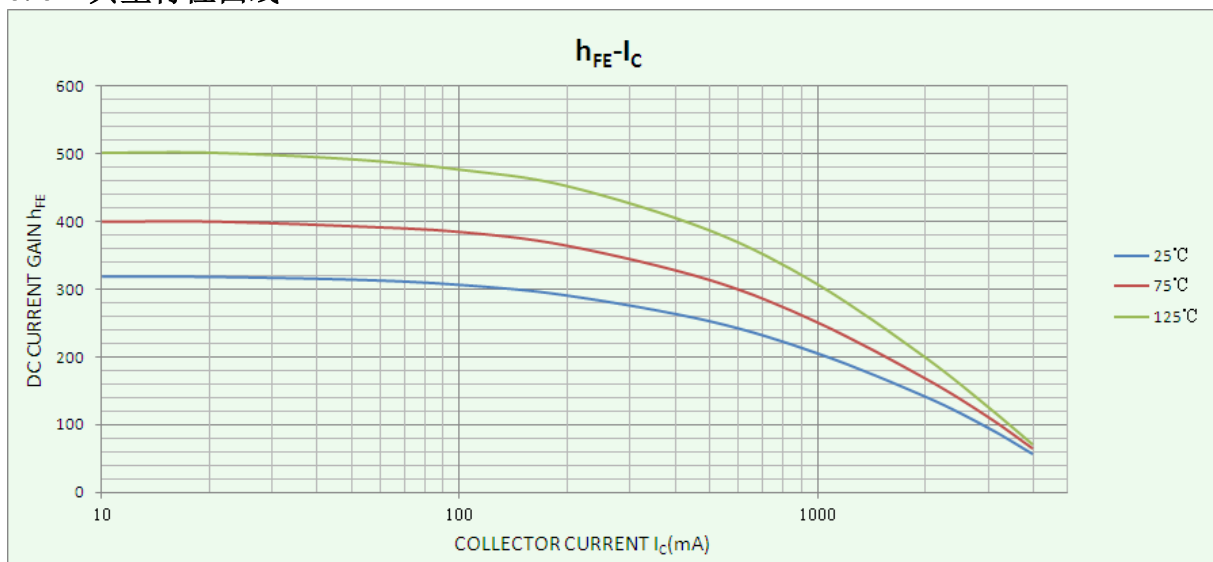
参数名称	符号	额定值	单位	备注
集电极-基极电压	V_{CB0}	-60	V	推荐封装形式: T0-92 荐成品型号: B772S
集电极-发射极电压	V_{CE0}	-50	V	
发射极-基极电压	V_{EB0}	-6	V	
集电极电流	I_C	-3.0	A	
耗散功率($T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$)	P_{tot}	0.625	W	
结温	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$	
贮存温度	T_{stg}	-55~150	$^{\circ}\text{C}$	

3.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
集电极-基极截止电流	I_{CB0}	$V_{CB} = -50\text{V}, I_E = -0$			-10	μA
发射极-基极截止电流	I_{EB0}	$V_{EB} = -6\text{V}, I_C = -0$			-10	μA
共发射极正向电流传输比的静态值	h_{FE}	$V_{CE} = -2\text{V}, I_C = -0.5\text{A}$	100		400	
集电极-发射极饱和电压	V_{CEsat}	$I_C = -2\text{A}, I_B = -200\text{mA}$			-0.5	V
特征频率	f_T	$V_E = -5\text{V}, I_C = -100\text{mA}$ $f=10\text{MHz}$	50			MHz

3.3 典型特性曲线



江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: <http://www.xs-elec.com>

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532



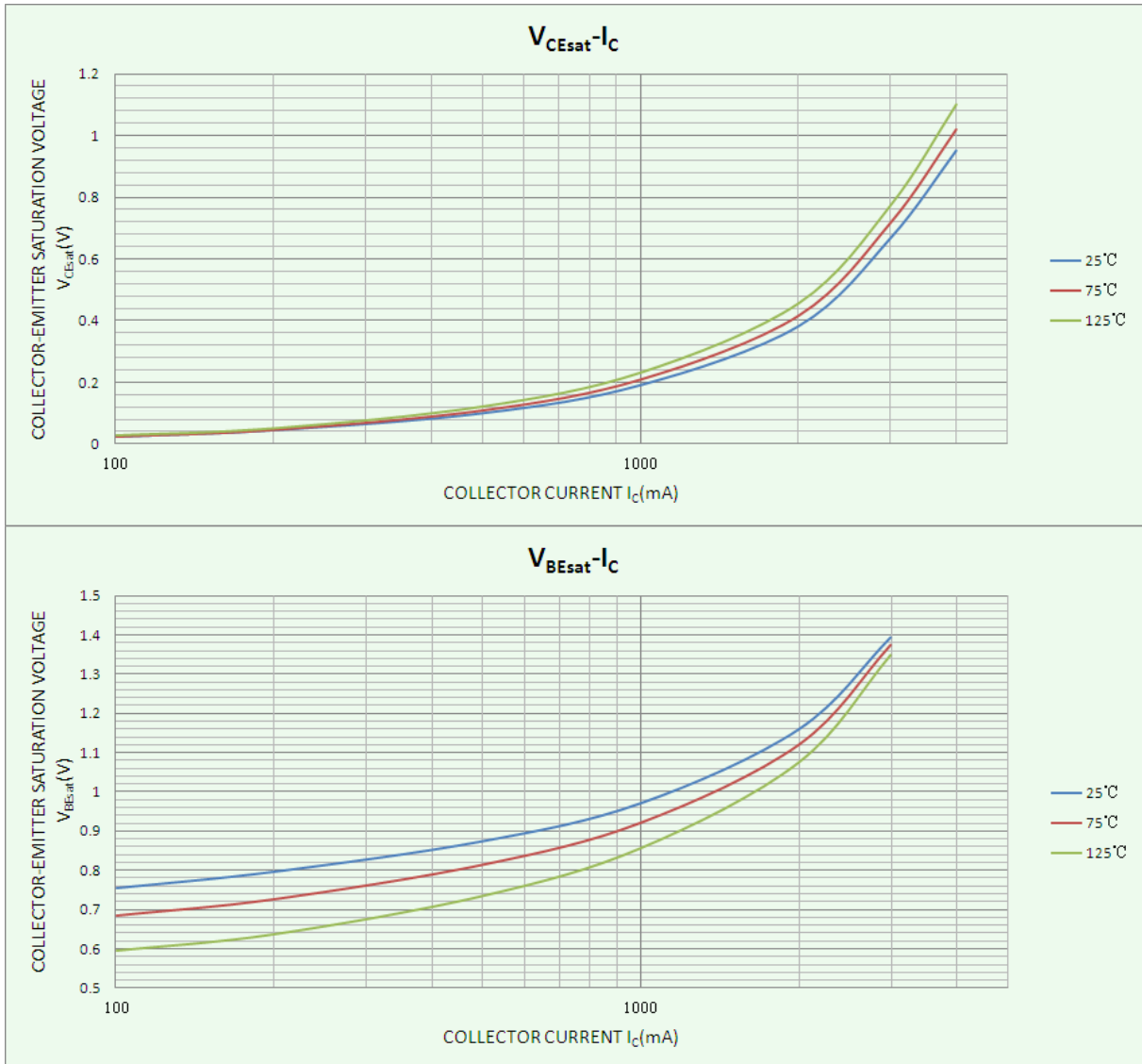
江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片
W2XP011F

高频放大环境额定双极型晶体管

文件编号 XS-W-081

版本号 18-B2-07

页码 3/3



注意事项:

- 芯片存储条件 (推荐): 氮气保护, 温度 $25 \pm 5^\circ\text{C}$, 湿度 $\leq 45\%$;
- 本产品说明书仅供参考, 不作为合同的一部分, 具体以双方签订的技术协议为准;
- 本产品说明书如有版本变更, 恕不另行告知! 客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新;
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能, 买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施, 以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: <http://www.xs-elec.com>

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532